⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公表

母公表特許公報(A)

平1-501433

❷公表 平成1年(1989)5月18日

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

審 査 請 求 未請求

部門(区分) 7(2)

H 01 L 31/04

E-6851-5F

予備審査請求 未請求

(全 7 頁)

②発明の名称

砒化ガリウム太陽電池システム

顧 昭62-507121 ②特

廖❷出 願 昭62(1987)10月15日

段翻訳文提出日 昭63(1988)6月14日 ❷国際出願 PCT/US87/02638

匈国際公開番号 WO88/03706

囫国際公開日 昭63(1988)5月19日

優先権主張

型1986年11月12日 野米国(US) 到929,571

エリオン、エム・エドムンド 砂発 明 者

アメリカ合衆国 カリフオルニア州 91006, アルカディア, ハイ

ランド・オークス 2152

砂発 明 者 ウオルフ, ジオージ アメリカ合衆国 カリフオルニア州 92648, ハンテイングトン・

ピーチ, ナインス・ストリート 303

ヒユーズ・エアクラフト・カン ⑪出 顋 人

アメリカ合衆国 カリフオルニア州 90045-0066 ロサンゼル

ス, ヒユーズ・テラス 7200

弁理士 鈴江 武彦 外2名 ②代 理 人

劉指 定 国

DE(広域特許), FR(広域特許), GB(広域特許), IT(広域特許), JP

[請求の範囲]

(1)頂部表面と第1の側部が第1の頂部表面録部で鋭角を 形成する横断面を有しているn型半導体層およびp型半導体 層を含むNオンPの第1の太陽電池と、

頂部表面および第1の側部が第1の頂部表面縁部で鋭角を 形成する横断面形態を有するp型半導体層およびp型半導体 層を含むPオンNの第2の太陽電池とを具備し、

前記第1および第2の太陽電池は前記電池の前記第1の頂 部表面緑部が事実上接触するように互いに機に隣接して配置

前記第1の太陽電池の前記n型層を前記第2の太陽電池の 前記p型廣へ電気的に接続するための手段を備えている太陽 電池モジュール。

- (2) 前記接続手段が前記第1の太陽電池の前記 n 型層と前 記第2の太陽電池の前記り型層との間に伸びている導電体の グリッドを含む、請求項1記載の太陽電池モジュール。
- (3) 導電体の前記頂部表面および前記グリッド上に透明な カバーを含む、請求項2記載の太陽電池モジュール。
- (4) 頂部表面と側部の1つが頂部表面操部で鋭角を形成す る平行四辺形の讃断面を有し、n型半導体層およびp型半導 体層を含むNオンPの第1の太陽電池と、

頂部表面と側部の1つが頂部表面録部で鋭角を形成する平 行四辺形の機断面を有し、p型半導体層およびn型半導体層 を含むPオンNの第2の太陽電池とを具備し、

前記第1および第2の太陽電池は前記電池の前記頂部表面 緑部が事実上接触するように互いに横に隣接して配置されて

前記第1の太陽電池の前記π型層を前記第2の太陽電池の 前記p型層へ電気的に接続するための手段とを備えている太 陽電池モジュール。

- (5)前記頂部表面および前記接続手段上に透明なカバーを 含む請求項4記載の太陽電池モジュール。
- (6) 前紀接続手段が前紀第1の太陽電池の前記n型層と前 記第2の太陽電池の前記p型層との間に伸びている導電体の グリッドを含む、請求項5記載の太陽電池モジュール。
- (7) 前記接続手段が、

前記第1の太陽電池の前記n型層上の導電体の第1のグリ ッドと、

前記第2の太陽電池の前記p型層上の導電体の第2のグリ ッドと、

前記第1のグリッドが前記第2のグリッドへ電気的に接続 されるように前記透明なカバーの底部表面上の導電体の対応 するグリッドとを含む、請求項5記載の太陽電池モジュール。

- (8) 前記太陽電池が砒化ガリウム太陽電池である、請求項 5記載の太陽電池モジュール。
- (9)各々が頂部および底部表面を具領し、第1の様方向に 傾斜する平行四辺形の横断面形態を有する複数のNオンP太 陽電池と、

各々が頂部および底部裏面を具備し、第1の横方向と反対

の第2の様方向に傾斜する平行四辺形の横断面形態を育する 複数のPオンN太陽電池とを具備し、

前記各NオンP太陽電池は1以上の前記PオンN太陽電池 と事実上接触しそれと横に隣接するように配置されており、

前記太陽電池アレイの隣接する太陽電池を電気的に相互接 統するための手段を備えている太陽電池アレイ。

- (10) 前記太陽電池の前記頂部表面上に透明なカバーを含む、 請求項9記載の太陽電池アレイ。
- (11) 各NオンP太陽電池の頂部表面録部が隣接するPオン N太陽電池の頂部表面録部と事実上接触しており、電気的に 相互接続するための前記手段が前記接触する頂部表面録部を わたって隣接する太陽電池の各対の前記頂部表面の間に伸び ている導電体を含む、請求項10記載の太陽電池アレイ。
- (12) 電気的に相互接続するための前記手段が更に頂部表面 録部で接触していない隣接する太陽電池の底面の間に伸びて いる複数の金属導電体を含む、請求項11記載の太陽電池アレイ。
- (18) 電気的に相互結合するための前記手段が前記太陽電池 の各々の前記頂部表面上の導電体のグリッドと、隣接する対 の前記太陽電池の前記頂部表面が電気的に接続されるような 前記透明なカバーの底部表面上の導電体の対応するグリッド とを含む、請求項10記載の太陽電池アレイ。
- (14) 前記太陽電池が砒化ガリウム太陽電池である、請求項 10記載の太陽電池アレイ。

費用製造技術が発展されるなら、字宙および地上の両方にお いて、従来の用途が増加されることが期待される。

砒化ガリウム太陽電池は適切な半導体層を基板上へ付着し、 それから電池を完成するように付加的成分を加えることによ って生成される。特に気粗形成のため、通常のPオンN砒化 ガリウム太陽電池はn型砒化ガリウム層を単語晶砒化ガリウ ム基板上にエピタキシャルに付着し、P型砒化ガリウムの暦 をn型砒化ガリウム階上へ付着させることによって生成され る。砒化ガリウムアルミニウムのP+層は電荷キャリアの表 面再結合を制限するためP型砒化ガリウム層上へ付着される。 電池が液相エピタキシャル方法によって生成されるときわず かに異なる成長手続が用いられる。一連の薄い導電性グリッ ドが電子を電池から収集パスパーへ撤送するためP+層上へ 付着される。ガラスの透明なカバーが、アクティブな半導体 部品を、宇宙空間において遠遇するような物理的接触および 放射線ダメージから保護するため砒化ガリウムアルミニウム 上に加えられる。p型砒化ガリウムは電池の動作中太陽に面 しており、技術用語で"PオンN"太陽電池と示される。

典型的に検方向に約2センチメータ×4センチメータである個々の太陽電池は使用可能な電圧および電流を生じるため大きなアレイに結合される。このアレイは1万個の個々の太陽電池を育することもある。各個々のPオンN太陽電池の電気出力は約0.9ポルトに過ぎないものであり、アレイにおいて多数のPオンN太陽電池は直列接続された太陽電池の電圧の合計である電圧を供給するため直列形式で接続される。

発明の背景

本発明は太陽電池に関するものであり、特に交互のP層上にN層の(NオンP)およびN磨上にP属の(PオンN) 砒化ガリウム太陽電池を用いる太陽電池アレイに関するものである。

半導体太陽電池は光エネルギを有用な電気電圧および電流に変換するため用いられる。簡単に言うと、典型的な半導体太陽電池はN型およびP型の透明な半導体材料の間にインターフェースを含む。インターフェース上の光照射はそれらに存在するキャリアに加えてホールー電子の対を生成し、少数電荷キャリアは反対方向にインターフェースを複切る。多数キャリアの補償流出は存在せず、そのため電荷のネット流が生じる。有効な電気電流はインターフェースのいずれかの側の材料への抵抗接触を形成することによって外部電流回路において得られる。

半導体太陽電池は広く様々な半導体材料から生成される。シリコン太陽電池は最も広く使用されるが、p型およびn型 砒化ガリウムから製造された電池が特に有望であることがわ かった。このような太陽電池はシリコン太陽電池と比較する と、寿命開始効率が高く、宇宙空間における時間および無に よる劣化が低い。砒化ガリウム太陽電池はそれ故特に魅力的 であり、既に制限された用途が発見されている。砒化ガリウム太陽電池が、特にもし太陽電池アレイの効率が改良され低

直列越気接続を達成するため、第1の太陽電池の上部層 (即ち、p型砒化ガリウム)は横に隣接する第2の太陽電池 の下部層(即ちn型砒化ガリウム)へ接続され、この接続法 は第2から第3の太陽電池へそして更に第4の電池へ銀返さ れる。この接続法は、横に隣接する太陽電池が十分な距離 (典型的には2gョ)をおいて離されていることを必要とし、 そのためコネクタは横に隣接する電池間に挿入され得る。

それ故、太陽電池アレイの効率を改善する必要性が存在する。更に効率的な太陽電池アレイは、構造の既知の太陽電池 材料の使用によって違成できる利点を用いることが望ましい。

特表平1~501433(3)

太陽電池アレイはまた構造の同じ材料から構成された存在するタイプのアレイよりも太陽電池環境における放射線ダメージに対する抵抗が少なくなってはならない。本発明はこの必要性を満たし、更に関連する利点を提供する。

発明の概要

本発明は改良された砂化がリウム太陽電池に帰するものであり、太陽電池アレイは改良された太陽電池を用いるを達れた太陽電池と同じ特性を必要された太陽電池は実質的に通常の太陽電池と同じ特性を対力る修正された構成を超入れ、加えてアレイの全出力効率を増加するを正された構成を超入れ、加えてアレイの全出を許容がある。改良された太陽電池を用いるアレイは投ぎのの太陽電池を明からないである。本発明の電池の異なる影となければ存在する、太陽電池アレイはきもなければ存在する太陽電池アレイはきもなければ存在する、放射線ダメージに対して同じ抵抗を有する。

本発明に従って、NオンP砒化ガリウム太陽電池は単結晶 砒化ガリウム基板と、基板上にエピタキシャルに存在する p+砒化ガリウムアルミニウムの単結晶層と、砒化ガリウム アルミニウムの層上にエピタキシャルに存在するp型砒化ガ リウムの単結晶層と、およびp型砒化ガリウムの層上にエピ タキャルに存在するn型砒化ガリウムの単結晶層を含む。電 池は短絡した問題なしに所望された位置で隣接する電池間の

太陽電池アレイの断面図である。

切って伸びている透明なガラスカバーの底部表面へ僻えられ、 従って隣接する電池の頂部層を接続する。太陽電池アレイは 互いに横に隣接するこのようなモジュールを置き、NオンP 太陽電池のp層の隣接する底部表面を隣接するモジュールの 隣接するPオンN太陽電池のn層へ電気的に接続することに

太陽電池アレイ中の後に隣接する、幾何学的に交互のNオンPおよびPオンN太陽電池の使用は、機に隣接する n 型およびp型層が "z"型コネクタのような頂部一底部コネクタの必要性を伴わずに直接一緒に接続されることができるので、太陽電池に大口の構成の容易さを増加させる。 結果的に、 太り高いアレイ効率を導く。 更に、 モジュールは、 アレイの付勢領域の大きな部分を影にする頂部パスパー接続を有さないアレイに接続されるように構成される。 本発明のその他の特徴および利点は、 本発明の原理を例を用いて説明する添け図面と共に得られた以下の更に詳細な説明から明らかとなるである。

図面の簡単な説明

第1図は通常のPオンN太陽電池の断面図である。

第2図はNオンP太陽電池の断面図である。

よって形成される。

第3図はPオンN太陽電池を組込んでいる通常の太陽電池 アレイの販売図である。

第4図は第3図の太陽電池アレイの頂部平面図である。

第5回は交互のPオンNおよびNオンP太陽電池を用いる

適切な電気接触を許容する平行四辺形の模断面を有する。動作中、n型砒化ガリウム層は太陽に面している。このNオンP電池は通常のPオンN砒化ガリウム太陽電池と同様の電気出力および放射線ダメージに対する抵抗を達成する。NオンP太陽電池はそれを保達しハンドリングを許容するガラスのような透明なカバーによって優われる。p型砒化ガリウムの層は宇宙放射線低下を制限するため典型的に約0.5マイクロメータの厚さであり、n型砒化ガリウムの層は典型的に約10ミクロメータの厚さである。

本発明のもう1つの観点によれば、太陽電池モジュールの 各セルはその頂部表面に別々のコネクタグリッドを育する。 対応するコネクタグリッドは、モジュール中の対の電池を機

第6図は第5図の太陽電池アレイの頂部平面図である。

第7図は隣接する太陽電池の頂部表面を電気的に接続する ためカバーガラス上のコネクタグリッドを用いる太陽電池モジュールの断面図である。

好ましい実施例の詳細な説明

第1図に説明されるように、通常のPオンN 砒化がリウム 太陽電池10は以下の方法で処理される。太陽電池10は砒化ガリウム単結晶基板12上に製造され、い 砒化ガリウム単結晶は 水平ブリッジマン技術によって製造される。 太陽電池の処理において用いるのに通切な落板は凝固単結晶から対象では であることによって提供さる。ウェハの表面方位は典型的に約(100)を規模される(立方体ミラー指数)。 切取り手続期間中に誘発される(立方体ミラー指数)。 切取り手続期間中に誘発される (立方体ミラー指数)。 切取り手続期間中に誘発される (立方体ミラー指数)。 切取り手続期間中に誘発される (立方体ミラー指数)。 切取り手続期間中に誘発される (立方体ミラー指数)。 切取り手続期間中に誘発される (立方体・フェハを研密することによって検索された ウェハはそれから残りの研密ダメージを除去すれた ウェハはそれから残りの研密ダメージを除去すんの治波中でエッチングされる。

n型砒化ガリウムの単結晶層14は砒化ガリウム単結晶基板12上にエピタキシャルに付着される。暦14の n型砒化ガリウムは好ましくは立方センチメータ当り約10¹⁸のネット電荷キャリア過度と約10マイクロメータの厚さを有する。

p型砒化ガリウムの単結晶層18は次に砒化ガリウムガリウ

暦14、18および18は当分野において既知の技術、好ましくは被相エピタキシャル生成または気相金属組成化学蒸気付着によって付着される。気相処理方法は上述されている。気相 金属組織化学蒸気付着は、ガス形態のトリメタルガリウムが 砒化水素ガスと混合されたとき発生する。混合物は分解して 砒化ガリウムとなり、低圧力室において750°で砒化ガリウム基板上に付着される。砒化ガリウム太陽電池の液相 エピタキシャル生成は砒化ガリウムの基板を砒化ガリウムで飽和されたガリウム溶液へ浸すことによって達成される。この処理は気相法とはわずかに異なる。シールされた、窒素浄化システムにおいて750℃の溶液によって実施される。ネット

約200℃の高さの温度で接着剤の維持を許容する。カルボ ランシロキサンポリマのような高分子量化合物の高温接着剤 が動作可能であることがわかった。

本発明の1観点に従って、第2図に示されるように、NオンP社化ガリウム太陽電池28は、先に説明された基板12に対してと実質的に同じである社化ガリウム単結晶基板28を供給することによって提供される。p+型社化ガリウムアルミニウムの単結晶層30は、表面電荷再結合を抑制するため、基板28上にエピタキシャルに付着される。p型社化ガリウムの単結晶層32はそれから層30上へ付着される。n型社化ガリウム層34はそれから層32上へエピタキシャルに付着される。バスパーを具備しないコネクタグリッド38はn型社化ガリウムの層34の上面に付けられる。最後に、透明カバー40がコネクタグリッド38および層84上に固定される。

層88、82および84の特性、層30、82および84を付着するための方法、コネクタグリッド88の幾何学的配列、構造および付着の方法、およびNオンP砒化ガリウム太陽電池28に関する週明カバーの構造および取付け方法は全て、先の政路に述べられたような、通常のPオンN砒化ガリウム太陽電池10の対応する状態と実質的に同じである。NオンP太陽電池28を形成するため活性層80、82および34を付着する順序のみが、通常のPオンN太陽電池10を形成するための層14、16および18を付着する順序と異なる。

NオンP太陽電池28がPオンN太陽電池10とほぼ同じ電気 的特性および放射線ダメージに対する抵抗を表わすことがわ 鐵荷キャリアは層中へ拡散される。

電気抵抗を低下させ、太陽電池10の上部表面への電気接続を容易にするため、金属コネクタグリッド20は太陽電池10の上面22上に付着される。この金属は通常のスパッタリングまたは蒸着技術を用いて真空環境において付程される。コネクタグリッド20の個々の非常に細い線は約2ミリメータ離され、そのため電子電荷キャリアはコネクタグリッド20の個々の禁子によって収集されるように半導体層14、16および18を経て容易に拡散する。もし個々の素子が広く離れすぎているなら、それらは電子を容易に収集することができず、電圧の損失が生じる。

透明なカバー24は上面22へ取付けられている。透明カバー24の組成および厚さは太陽電池10の電気的特性を能率的にするように透択される。透明カバー24が約200マイクロメータの厚さを有するコーニンググラス型式7940のようなシリカガラスであることが望ましい。透明カバー24は3つの電便を凝能を果たす。第1に、カバー24は光を層14および18に通過させる。第2に、カバー24は太陽電池10の残りの煮子を支持する。第3に、カバー24は物理的ダメージや低エネルギ陽子や紫外線のような宇宙環境におけるある種の放射線から太陽電池10の残りの素子を保護する。

透明なカバー24は透明接着剤または静電気接着のような任意の適切な技術によって層18へ接着される。もし焼きなましが放射線による特性低下を減少するため用いられるなら、接着技術は使用時における層の分離を阻止するために、

かった。事実、NオンP 砒化ガリウムガリウム太陽電池の電気的特性は通常のPオンN 砒化ガリウム太陽電池と比較して、時間の経過に伴ってわずかに低下する。通常のPオンN 太陽電池から得られる最大電力はフルーエンス(fluence) 1019で1MEVの電子を照射されるときおよそ20パーセント低下し、それは同期軌道においてほぼ5年に相当する。

個々のPオンN太陽館池10は各々約 D. 9ポルトの電圧出力を発生するが、それは宇宙環境におけるある実際の適用のためには電圧が小さすぎる。PオンN太陽電池10はそれ故個々の太陽電池10によって発生した電圧の合計に等しい出力電圧を得るため通常は直列形態で一緒に留められている。直列に連結された太陽電池の個々の群はそれから必要とされる電流の増加を達成するため並列形態で一緒に留められる。

第3図および第4図は通常の太陽電池アレイ42を形成するため通常のPオンN太陽電池を相互結合するための方法を示す。直列接続を達成するため、1個の太陽電池10の頂部すなわちp型層16はp+層18を経て隣接する電池の基板12を経て底部即ちn型隔14へ電気的に接続されなければならない。用いられたコネクタの型は、断面図において見られるときのそれらの形状のため、・2コネクタ・44と呼ばれる。 ェコネクタ44は、これらの素子を隣接する太陽電池10へ接続するため各電池上にグリッド20を相互接続するバスパーへ接続される。通常の2コネクタ44は各端部の水平部分と、太陽電池の頂部から底部へ伸びている傾斜部分とを含んでいる。水平部分は接続を形成するため太陽電池10のバスパーへはんだづけその

特表平1-501433(5)

他により接続される。 z コネクタ44の水平部分およびバスバーの下の取付け領域は、層14と16との間の接合部がコネクタおよびバスバーによって太陽光線から思されているので、付勢されず電流を発生できない。通常の太陽電池アレイ42の電気出力はそれ故隣接する太陽電池の間の空間のためその電位電流出力以下へ減少され、それはコネクタ44へ適応させるため維持されなければならず、コネクタおよびバスパーによって隠された非付勢領域は各太陽電池の1 側部に沿って伸びている。

本発明のもう1つの観点に従って、PオンN太陽電池およびNオンP太陽電池は、個々の太陽電池が更に接近して置かれているので、また同じ形態で太陽電池の上部表面へ接合されたパスパーが取除かれるのでその電流出力効率が増加されるような太陽電池アレイを形成するように幾何学的に交互にされている。

第5 図および第6 図は、PオンN太陽電池10およびNオンP太陽電池26がモジュール56として一緒にグループ分けされているような第1 の形態48を示す。このようなモジュール56において、コネクタグリッド58は太陽電池10と28との間でモジュール56の上部接面上に連続的に伸びており、PオンN太陽電池10のp層をNオンP太陽電池28のn層へ電気的に接続する。非導電性接着剤50は電池10および28の両方を各モジュール58を形成するため一緒に堅く接着するため用いられる。これはコネクタグリッド58を、電池の頂部表面をわたって延在するように蓋着させることを可能にする。第5 図において

強率して示されるように、各電池は、形成するときその側部がゆるい傾斜を有するように正常の結晶から非常に扱やかな角度で形成される。各モジュール58の太陽電池10、28は頂部表面録部52で接触している。頂部表面録部52で各電池10の頂部表面および側部によって形成された角度は典型的に90°から約1°まで逸説する。これは頂部表面で適切な電気接触を生じるとき電池のショートを防ぎ、非付勢表面領域を最少にするための隣接する電池側部の十分な分離を与える。隣接するモジュール56は金属コネクタ60によってそれらの下面でのみ一緒に接続される。金属コネクタ60は第1の付勢対58のNオンP太陽電池28から第2の付勢対58のPオンN太陽電池10への電気接続を行なう。

形態48は通常の太陽電池アレイ42においてみられる電気出 力損失の両方の幾何学的協成部品を減少することによってア レイの出力能率を最大にするため用いられる。各モジュール 58を構成する2つの太陽電池間に空間がないので、隣接す、 電池間の空間のための損失は非常に減少される。加えて、グ ッド58の使用によって取除かれる。即ち、放慢でする太 を接続する上部パスパーの必要性は連続コネクタグツッド58の使用によって取除かれる。即ち、防煙でする を接続する上部パスパーによって太陽から を接続する上部パスパーにするものは形態48を構成する 電池の上部表面の領域には存在しない。電池間の空間 が約4パーセントの能率増加を生じることが推測される。更 に形態48における頂部パスパーの除去が約6パーセントの能 率増加を生じることが推測される。従って、アレイのユニッ

ト領域当りのワットについて、第5図および第6図において 説明された形態48の能率の全改善は10パーセントに等しい。

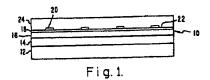
第7図において示された第2の形態においては、モジュール58の太陽電池10、28の電気的相互接続が透明なカバーガラス84上の夢電体グリッド62によって形成される。第1図および第2図に示されるように太陽電池10は導電体グリッド20を含み、太陽電池28は導電体グリッド36を含む。グリッド62はグリッド20および36とを整合するためカバーガラス64上に配置され、カバーガラスグリッド62と2つの太陽電池グリッド20および36は2つの電池よりなるモジュール56を形成するため一緒に融合される。この方法で、2つの電池は共に竪く保持される気的に接続される。個々のモジュールは底面に沿って金属導電体によって相互接続される。

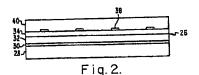
図示されていないもう1つの実施例において、一対のPオンNおよびNオンP太陽電池はモジュールを形成するため金属等電体によって底面上で一緒に接着される。個々のモジュールはそれから第7図において示されたものと同様のカバーガラス上のコネクタグリッドと個々のモジュールの隣接する電池とを相互接続することによってアレイを形成するため隣接するモジュールと接合される。

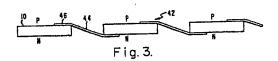
正しく評価されるように、実質的に同じ電気特性および放射線による特性低下に対する抵抗性を有する補足的なNオンP太陽電池の開発は、アレイの隣接する太陽電池間の頂部ー底部電気接続の必要性を取除くことによってアレイのユニット当りの増加された電気出力を有する大きな太陽電池アレイ

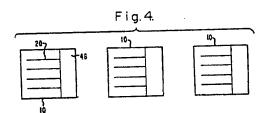
の構造を許容する。太陽電池アレイの組立ては各々2つの太陽電池を組入れているモジュールの使用によってより容易にされる。このモジュールは別々に組立てられ、それから個平コネクタパーを用いて太陽電池アレイへ接合されてもよい。本発明の特定の実施例が説明のために詳細に記述されたが、様々な修正が本発明の技術的範囲から外れることなく為されても良い。従って、本発明は添付された請求の範囲によってのみ制限されるべきである。

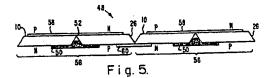
特表平1-501433(6)

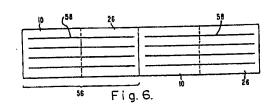


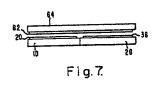




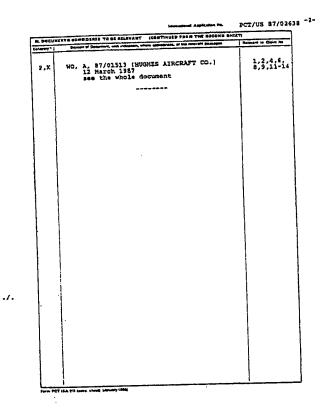








ABUNCAYUN OF NOAMET MAYTER (CAMPAI CHANGE CHANGE MAY INC.) 1. H O1 L 25/04; H O1 L 31/06 1. H O1 L 25/04; H O1 L 31/06 1. H O1 L 25/04; H O1 L 31/06 1. H O1 L 25/04; H O1 L 31/06 1. H O1 L Description Representation Notices Bellevia Bellev		国 祭 鍋		/n= 07/03638		
BOLUMENTS Consistency Development of the control		and a live to the same of the same of the same	relian sombell spair, indicate all) 4	VS 5179293B		
H 01 1 25/04; H 01 L 31/US	CLASUIV	AMERICAN PARTY CLASSICATION (IPC) OF 12 DOIN HAND	VM ERROMATORN BUT ILL			
SOL L	·c ⁴ .	H 01 L 25/04; H 01 L 31/	06			
Description before the Notice Service States Promote to the August 1972 Description of the Louis Bet much Description of the Louis Between Description of the Louis Between Personnel or Included in Confess Louis Between Personnel or Included in Confess Louis Between Personnel or Included in Confess Louis Between Personnel or Included	PILLUS I	PEACHED House Become	ston Septement 1			
BOLL Contemplate Secrete computes Number of Peace Secrete and Lord Secretary of the Relayant of the Peace Secretary To Cours of Occupant to the Relayant of the Secretary of	AMIES PARE					
DOCUMENTS COMMERCIAN TO BE RELEVANT TO CHARLE OF STREETS OF JAPARN, VOLUME 3, NO. 11,4,5,9, 1317 (2-164), 31 October 1979. BENEFIT ADSTRUCTS OF JAPARN, VOLUME 3, NO. 1,4,5,9, 11,12,14 LY A, 54107699 (DAINY SETKOSHA K.K.) 23 AUGUST 1979 Ruse the whole document US, A, 1170885 (M.P. AUSTERDAN et al.) 27 Fabruary 1968 Ruse the whole document EP, A, 0000715 (M.H. BLOSS) 21 February 1979 Ruse the whole document EP, A, 0000715 (M.H. BLOSS) 21 February 1979 Ruse the whole document EP, A, 3200685 (SOCIETE MATICALE INDUSTRIELE ALROSSATIALE) 27 AUGUST 1982 US, A, 1278811 (H. MORI) 11 October 1966 A PATON ADSTRUCTS OF JAPARN, VOLUME 8, NO. 16 (E-227)(14771), 16 February 1984, 6 JP, A, 53194376 (KORANSU DENSIL KINGOU K.K.) 12 November 1983 Final densymptor of one of commence of the control of the cont	×5 ⁴					
PACENTE CONTRIBUTION OF SET RELEVANT PACENT ADSTRACTED WE SET RELEVANT PACENT ADSTRACTED AND SET RELEVANT 111 (2-148), 31 October 1979, 10. 1,4.5.9, 113 (2-148), 31 October 1979, 10. 1,4.5.9, 11,12-14 E. JP, A. 54107650 (DAIRY SETENDRA K.K.) 23 AUGUST 1979 Res the Whole document US, A. 1170986 (N.P. ANSIERDDAN et al.) 27 Fabruary 1968 see the whole document EP, A. 0000715 (W.H. BECSS) 21 February 1979 10, 11n 2 - page 10, 11n 3 - page 10, 11n 3 - page 10, 11n 3 - page 10, 11n 2 - page 10, 11n 3 - page 10, 13 EF, A. 2306685 (SOCIETY NATIONALE TRUBUSTYLELIE ALROSPATIALE) US, A. 3278811 (H. NORI) 11 October 1966 PRATON ADSTRACTS Of Japan, volume 8, BO. 36 (2-227)(14771), 16 Fabruary 1984, 6 JP, A. 3194378 (KONARSU DENSHI KINZOKU K.K.) 12 Movember 1883 EPACENT OF THE SET OF		Gottomentation Bearches often to to the Errore But such December:	on Musicum Decumentation are Included in the Flotta Sampled &			
Patent Abstracts of Japan, volume 3, no. 11.4.5.9, 11.1 (2-148), 11. October 1979 2. JP. A. 54.076 Debin's SEKOSHA K.K. 23 Naguet 1979 ass the whole document US, A. 1170986 (N.P. ARSTERDAN et al.) 27 Fabruary 1968 see the whole document EF, A. 0000715 (M.H. BLOSS) 21 February 1979 see 1500085 (SOCIETT MATTONALE THURSTRIELLE ARROSPATIALE) 27 August 1982 US, A. 2278811 (H. MORT) 11 October 1966 A Patent Abstracts of Japan, volume 8, No. 26 (2-227)(14771, 16 February 1984, £ JP. A. 5194378 (KONATSU DENSHI £ LY JA 1985 (M. S. 1984) Patent Interpreted Seate december 1984 **** *** *** *** *** *** ** *						
Patent Abstracts of Japan, volume 3, no. 11.4.5.9, 11.1 (2-148), 11. October 1979 2. JP. A. 54.076 Debin's SEKOSHA K.K. 23 Naguet 1979 ass the whole document US, A. 1170986 (N.P. ARSTERDAN et al.) 27 Fabruary 1968 see the whole document EF, A. 0000715 (M.H. BLOSS) 21 February 1979 see 1500085 (SOCIETT MATTONALE THURSTRIELLE ARROSPATIALE) 27 August 1982 US, A. 2278811 (H. MORT) 11 October 1966 A Patent Abstracts of Japan, volume 8, No. 26 (2-227)(14771, 16 February 1984, £ JP. A. 5194378 (KONATSU DENSHI £ LY JA 1985 (M. S. 1984) Patent Interpreted Seate december 1984 **** *** *** *** *** *** ** *	0004	SHOP COMMITTIES TO BE RELEVANT!				
PACENT ADSTRACTS AND	*****	Clickes of Opcoment, 11 onth incitation, unger con-	oprigit, d) into opposite passages "I	Research to Claim 44.35		
27 Fabruary 1968 mee the whole document EP, A, 0000715 (W.H. ELOSS) 21 February 1979 see figures 1-37 page 1, 12 page 1,	^	131 (E-148), 31 Octo 5 JP, A, 54107690 (E E.K.) 23 August 1975	Patent Abstracts of Japan, volume 3, no. 1, 131 (2-148), 31 October 1978, 11 5 JP, A, 54107690 (DAINT SETKOSHA K.K.) 23 hugust 1979			
FR. A. 2300685 (SOCIETE NATIONALE INVISITELEILE ALROSPATIALE) 27 August 1982 US. A. 3278811 (H. NORI) 11 October 1966 Patent Abstracts of Japan, volume 8, no. 36 (E-227)(14781), 16 February 1984, 6 JP. A. 53194376 (KONATSU DENSIL KINZORU K.K.) 12 November 1983 Final sempers of the desirement of the semple of the sempl	^	27 February 1968 see the whole docume	IS, A, 1170986 (M.F. AMSTERDAN et al.) 27 February 1968 see the whole document			
FR. A. 2300685 (SOCIETE NATIONALE INVISITELEILE ALROSPATIALE) 27 August 1982 US. A. 3278811 (H. NORI) 11 October 1966 Patent Abstracts of Japan, volume 8, no. 36 (E-227)(14781), 16 February 1984, 6 JP. A. 53194376 (KONATSU DENSIL KINZORU K.K.) 12 November 1983 Final sempers of the desirement of the semple of the sempl	*	EP, A, 0000715 (M.H. BL see figures 1-3; pag 10, line 22	rp, A, 0000715 (M.H. BLOSS) 21 February 1979 see figures 1-3; page 7, line 1 page 10, line 22			
Patent Abstracts of John, volume 8, no. 16 (2-227)(1471), 5 Pabrulary 1984. 5 JP, A. 58194378 (XONASSU DENSIT KINZOND K.K.) 12 November 1983 Special interpret of one of contention of the second	*	FR, A, 2500685 (SOCIETE INDUSTRIELLE AEROSP 27 August 1982	ATIALE)			
By Carlot Conference of the descendent of the conference of the co				ł		
*** Comment of the Co		36 (E-227)(1473), 1 c vp 1 58194378 (KOMATSU DENSHI vember 1983			
CERTIFICATION But M vin Active Companies of the international Search Ones of the state Companies of the international Search 1 2 APR 1388 Security of Authority Amounts Description of Authority Amounts	"A" 604 "T" 644 "T" 644 "T" 644	summer gebinning you generall friesd of the part work. Journal to be an appealant incomments have goodstanded bod publishing on at 4819 the intermediated of date. Industry which showly finish albushing on pricerys distinct of the its control to columbia. He superations that of positions which is process income last processor and the general pricerying to the organizations, who publishes on greater pricerying to the organizations, only publishes on the control of the control of the control of the processor.	"A" described of periodic refers garry pp granuser to the collection of the collecti	S Symmet to a potable factor of the control of the property of the control of the		
T Z APR 1988 9th, Naroh 1988 Security Author Conference Conferen	-p- 644	of their tae extends face started	.E. Sections moupes by pur rey.	4 Sector -5		
9th, March 1988 12 APR 1988	IV. EERY	IPICATION	Date of Hatting of the International	Search Report		
Semantined Socreting Amounts			1 2 APR	1388		
11/2			Separation of Assessment Office	5		
		EUROPEAN PATENT OFFICE		V		



30 家 賃 奎 % 告

US 8702638

This manus was the passes fundly magazine retailing to the protest dearmous client in the parties described in the European state Clien EDP for us 1,192,193 This common's now an entrained in the European Fatter Clien EDP for us 1,192,193 The European Paparet Clien is no so well hadde for from particulary neats not carrier place for the purpose of information.

Parate durament phots to progrets report	Parisana See	Price (mily artistry)		President date
US-A- 3370986		FR-A- 1421675		
EP-A- 0000715	21-02-79	DE-A,C	2732933	08-02-79
		AU-A- US-A-	3810878 4283590	24-01-80 11-08-83
		ÃÚ-8-	519312	26-11-81
FR-A- 2500685	27-08-62	lione		
US-A- 3278811		Hone		
WO-A- 8701513	12-03-67	EP-A-	0236447	16-09-87
	,			
		•		
		_		

mis Page Blank (uspto)